

BU508AF

Мощный кремниевый биполярный диффузионный n-p-n транзистор.

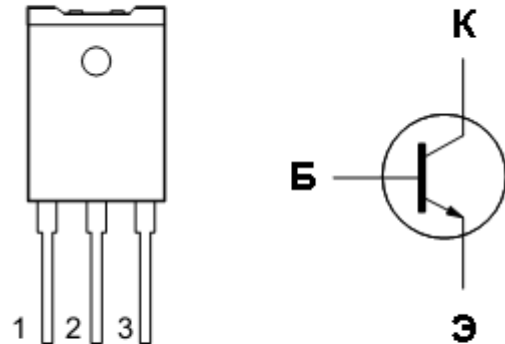
ОСОБЕННОСТИ:

- Повышенная производительность, высокое напряжения, высокой скоростью переключения NPN транзистор в пластиковом корпусе.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Транзисторы используются в строчных развертках черно-белых и цветных телевизоров.

ТО-3PN



- База
- Коллектор
- Эмиттер

Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации при Токр. среды = 25 °С.

Обозначение	Параметр	Значение	Единицы измерения
Uкэ пик.	Напряжение коллектор-база (Uэб=0)	1500	В
Uкэ max	Напряжение коллектор-эмиттер (база открыта)	700	В
Iк max	Постоянный ток коллектора	8	А
Iк пик.	Пиковый ток коллектора	15	А
Iб max	Постоянный ток коллектора	4	А
Iб пик.	Пиковый ток коллектора	6	А
Pк max	Рассеиваемая мощность коллектора с радиатором	34	Вт
Tj	Температура перехода	150	°С
Tamb	Диапазон рабочих температур	-65 до 150	°С
Tstg	Диапазон температур хранения	-65 до 150	°С

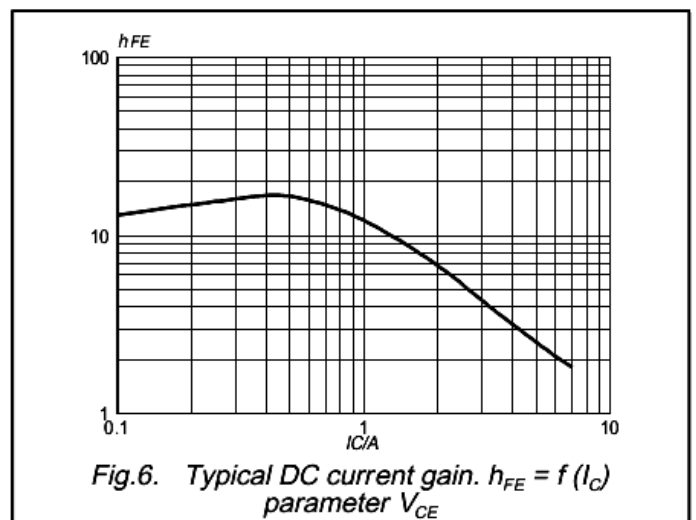
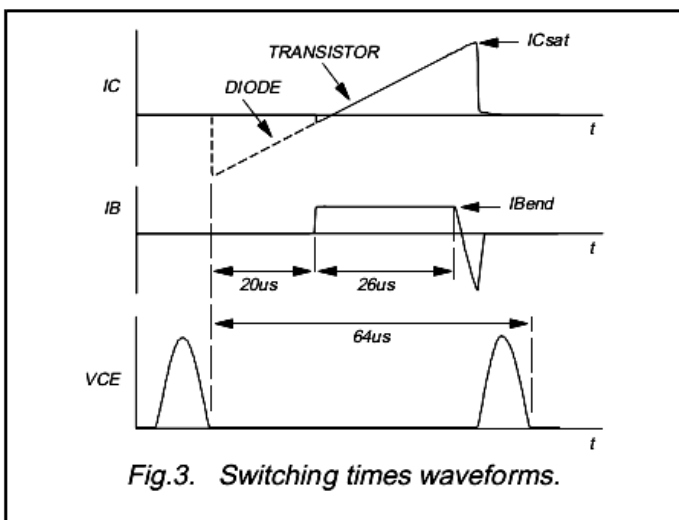
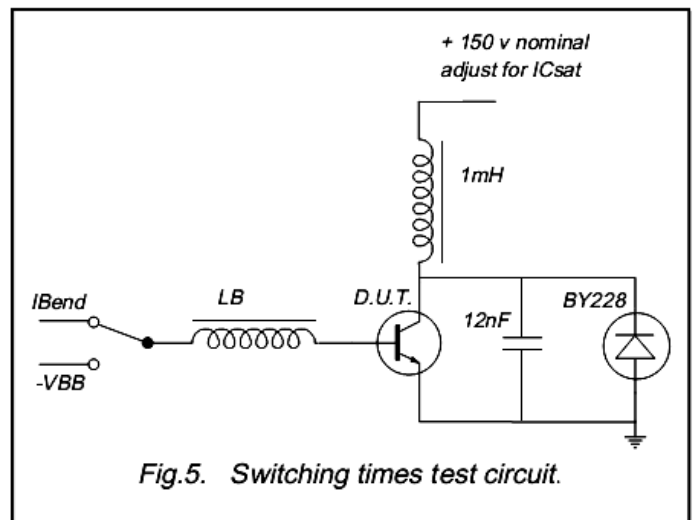
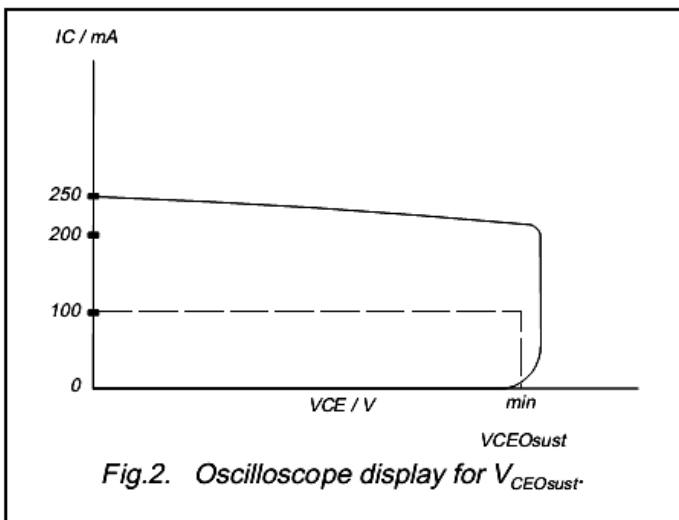
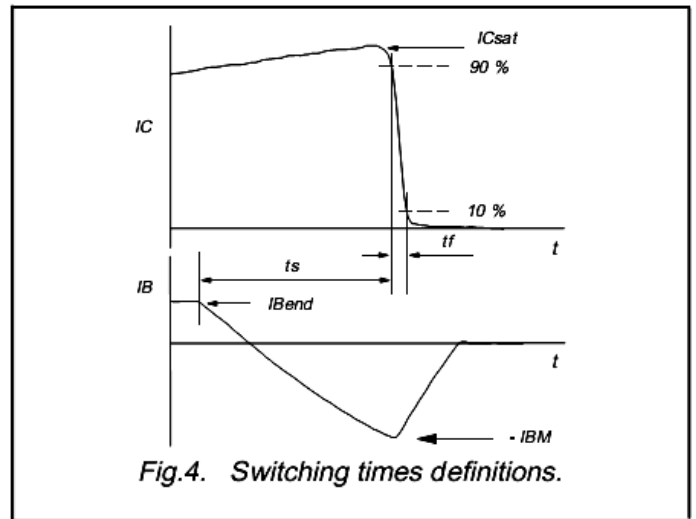
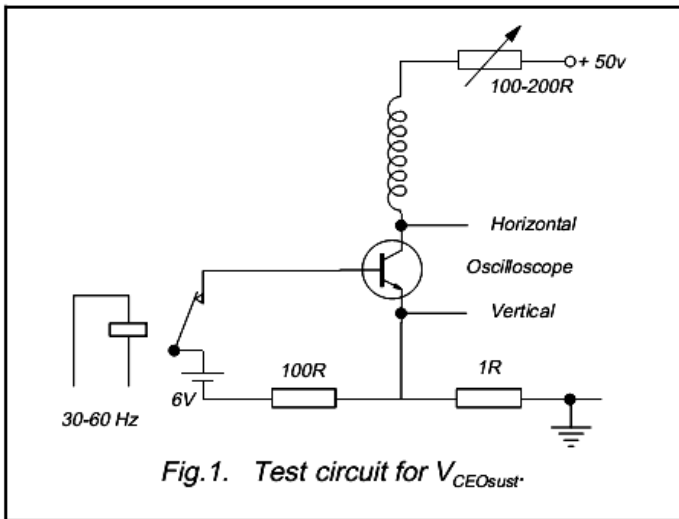
Тепловые характеристики при Токр. среды = 25 °С.

Обозначение	Параметр	Значение	Единицы измерения
Rthj-hs	Тепловое сопротивление кристалл-радиатор без термопасты	3.7	К/Вт
Rthj-hs	Тепловое сопротивление кристалл-радиатор с термопастой	2.8	К/Вт
Rthj-a	Тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда	35	К/Вт

Значения изоляционных характеристик при Tрадиатора=25°С.

Обозначение	Параметр	Условия испытания	Мин.	Тип.	Макс	Единицы измерения
U изол.	Повторяющееся пиковое напряжение на выводах к внешнему радиатору	Влажность не более 65% без пыли			2500	В
C изол.	Емкость к внешнему радиатору	f=1МГц		22		пФ

ГРАФИКИ ХАРАКТЕРИСТИК



ГРАФИКИ ХАРАКТЕРИСТИК

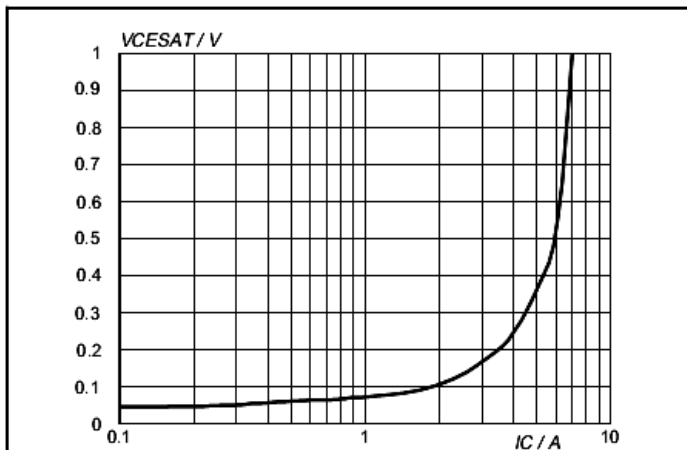


Fig.7. Typical collector-emitter saturation voltage.
 $V_{CEsat} = f(I_C)$; parameter I_C/I_B

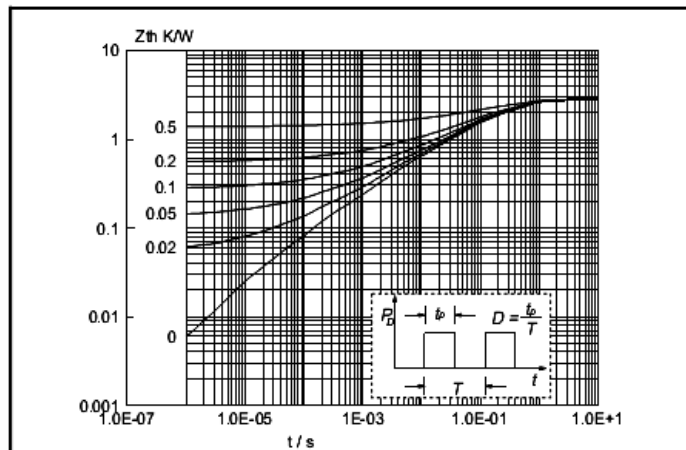


Fig.10. Transient thermal impedance.
 $Z_{th-hts} = f(t)$; parameter $D = t/T$

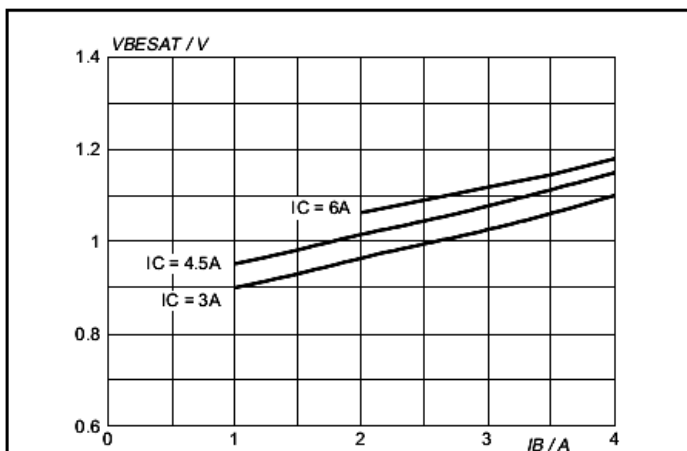


Fig.8. Typical base-emitter saturation voltage.
 $V_{BEsat} = f(I_B)$; parameter I_C

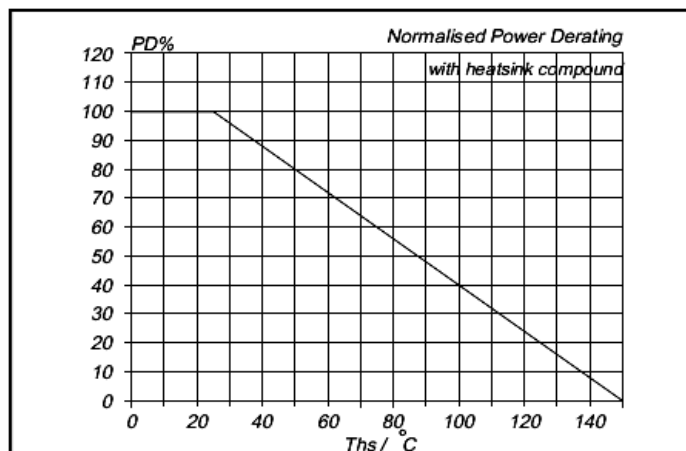


Fig.11. Normalised power dissipation.
 $PD\% = 100 \cdot P_D / P_{D,25^{\circ}C} = f(T_{hs})$

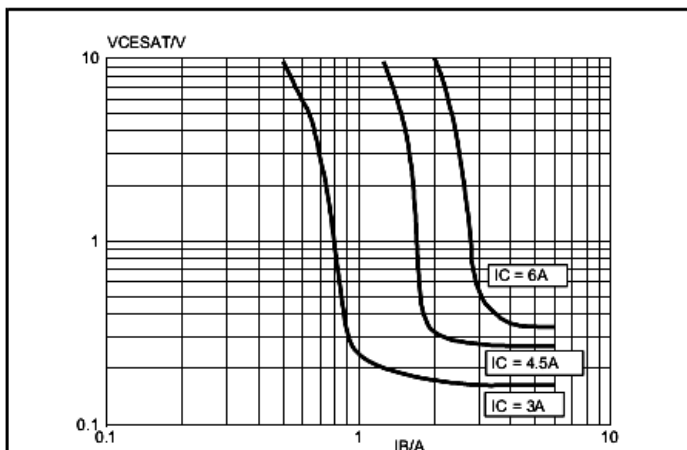


Fig.9. Typical collector-emitter saturation voltage.
 $V_{CEsat} = f(I_B)$; parameter I_C

ГРАФИКИ ХАРАКТЕРИСТИК

